### باسمه تعالى



دانشکده مهندسی برق اصول الکترونیک و آزمایشگاه گروه دکتر فخارزاده

# گزارش فاز دوم پروژه

على شيرالى (94109165) سيّدمحمّدامين منصورى (94105174)

#### 1- درباره انتخاب نوع طبقه خروجي

با توجه این که مایلیم طبقه خروجی zizo باشد، دو انتخاب برای نوع طبقه خروجی داریم: 1) کلاس B با فیدبک، 2) کلاس AB

تقویت کنندههای کلاس AB که مطابق شکل1 با مقاومت بایاس شده باشند نمی توانند توان DC و سوئینگ را همزمان تامین کنند. چرا که:

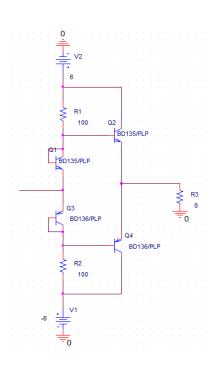
$$v_{o,pp} = 8 V \rightarrow i_L = 500 \, mA$$

با فرض eta=50 ، برای تامین این جریان و روشن ماندن diode connected ها، میبایست:

$$\frac{6 - 4 - 0.7}{R} > \frac{i_L}{\beta} \to R < 130 \ \Omega \to I_{DC} > \frac{12}{2 * 130} = 46 \ mA \to P_{DC} = 12 * I_{DC}$$

$$> 550 \ mW$$

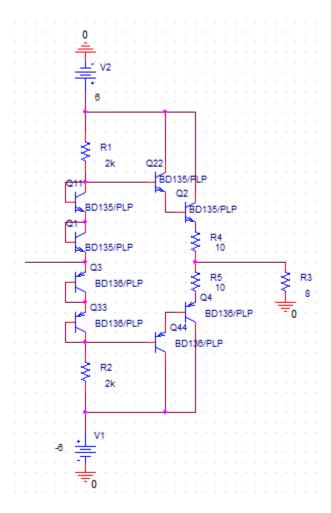
که از حد بالای توان ما (200 mW) بسیار بیشتر است.



شكل1

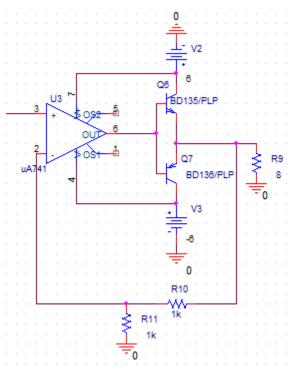
راه حل بهتر استفاده از بایاس با منبع جریان است. این نوع بایاس در تئوری کلیه شرایط را تامین می کند اما با توجه به mismatch بین ترانزیستورها، در عمل نتوانستیم خروجی پایدار و zizo بگیریم.

راه دیگر استفاده از آرایش دارلینگتون (شکل2) است. این آرایش می تواند سوئینگ و حد توان DC را برای ما R5 و R4 هاید مقاومتهای R5 و R4 از ترانزیستورهای R5 و R5 باید مقاومتهای R5 و R5 باید منظور برای مانع شدن از عبور جریان R5 از ترانزیستورهای R5 و R5 باید R5 و R5 و R5 باید R5 و R5 و



شكل2

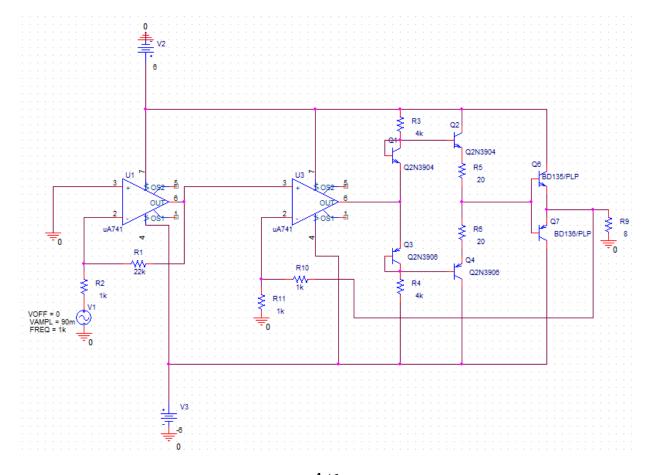
نهایتا تنها گزینه روی میز استفاده از طبقه خروجی کلاس B با فیدبک است (شکلB). توان DC این طبقه تقریبا صفر است. فیدبک سری-موازی نیز با توجه به بزرگ بودن ضریب تقویت opamp، ناحیه deadzone را به خوبی از بین میبرد.



شكل3

#### **2- طراحی نهایی**

مسئله ای که در عمل با آن روبهرو شدیم، اثر لودینگ روی opamp بود. بدین منظور تصمیم گرفتیم یک طبقه بافر بین opamp و push-pull اضافه کنیم. این طبقه نیز به صورت push-pull کلاس AB طراحی شد تا بتواند جریان و سوینگ لازم را با مصرف کم توان DC تامین کند. لازم به ذکر است در اینجا نیز برای مانع شدن از عبور جریان DC، در امیتر ترانزیستورهای 2 و 4 (شکل4) مقاومت قرار می دهیم اما این بار با توجه به این که امپدانس دیده شده در خروجی بافر (ورودی push-pull کلاس A) بسیار بیشتر 8 اهم است، محدودیت سابق را روی اندازه این مقاومتها نداریم. نهایتا شماتیک طبقه خروجی به همراه طبقه تقویت در شکل4 قابل ملاحظه است.



شكل4

#### 3**– شبیهسازی**

برای شبیه سازی از نرم افزار HSPICE استفاده می کنیم. ترانزیستورها BD138-9 با نام HSPICE استفاده می کنیم. ترانزیستورهای 2N3904-6 با نام mynpn-pnp مطابق زیر مدل می شوند:

.model mynpn npn bf=250 is=1f

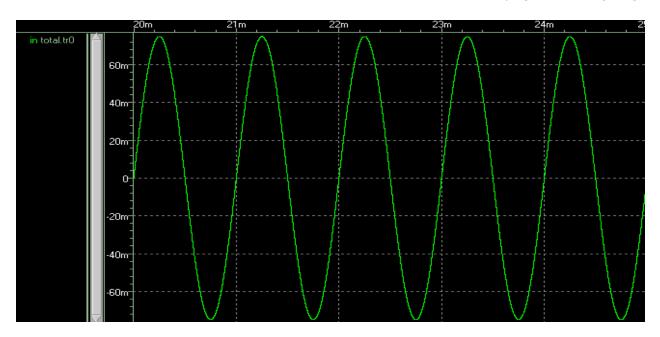
 $.model \qquad mypnp \qquad pnp \quad bf = 200 \qquad is = 1f$ 

.model mynpnpower npn bf=50 is=1f

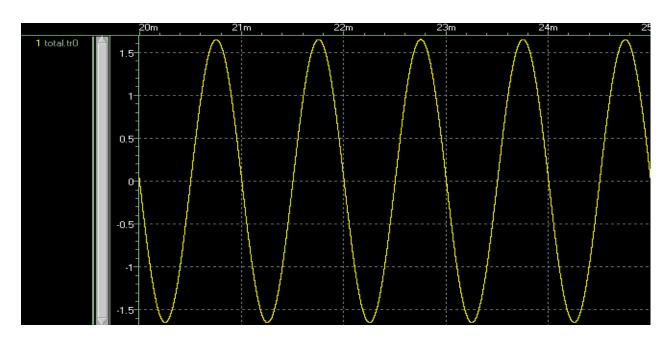
.model mypnppower pnp bf=40 is=1f

برای مدل کردن opamp نیز از مدل uA741 برگرفته از Utah.edu استفاده می کنیم.

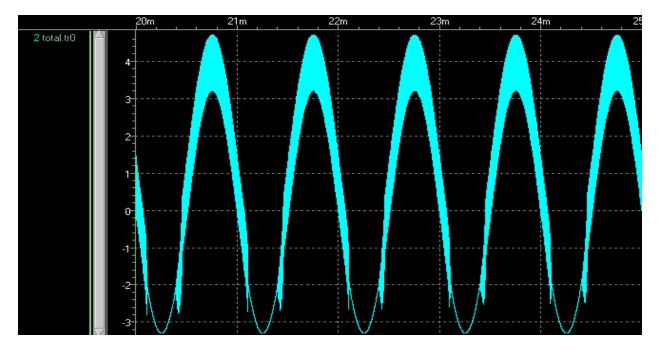
modulator برای ورودی mV شبیه سازی مدار را با مقادیر شکل 4 انجام می دهیم. به جای بار 6 اهمی نیز 6 شبیه سازی مدار را با مقادیر شکل 6 انجام می دهیم. به جای بار 6 شبیه آن پرداختیم قرار می گیرد. برای 6 6 7 و 6 7 8 و مختلف در شکلهای <math>6 تا 8 رسم شده است.



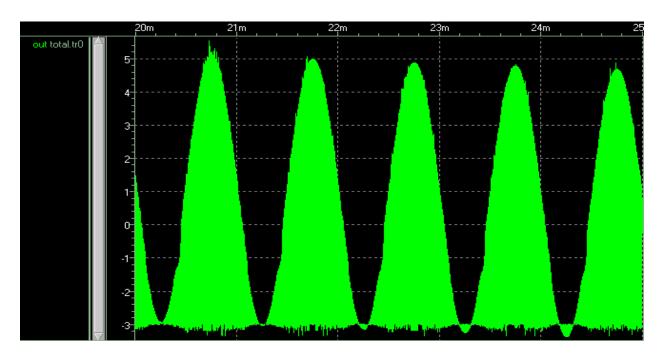
شكل5 ( ورودى)



شكل6 ( خروجي طبقه تقويت)



شكل7 ( خروجي طبقه خروجي)



شكل8 ( ورودى)

## 4- نتایج شبیهسازی مشخصات مورد انتظار

مشخصات تقویت کننده و طبقه خروجی با بار 8 اهمی گزارش شده است.

بررسی	مشخصه
دارد (با تغییر مقاومتهای R1 و R2)	قابلیت تنظیم بهره
دارد (سوئینگ 8 ولتی روی 8 اهمی معادل با 1 وات)	قابلیت درایو کردن بلندگوی 8 اهمی 1 واتی
هست	طبقه خروجی به صورت discrete
هست	منبع تغذیه ±6 <i>V</i>
دارد (بیش از 8 ولت)	سوئینگ خروجی بیش از $V_{pp}$ 7 $V_{pp}$ *)
تا حدى دارد (البته deadzone ايجاد مىشود)	پهنای باند بیش از 15 kHz
هست (خروجی کمتر از mV 5 برای ورودی صفر)	zizo
هست (برای خروجی 1V و 1kH ، 0.4 درصد)	THD کمتر از 1 درصد (*کمتر از 0.1 درصد)
هست (حدود 100 mW)	توان در حالت ورودی صفر کمتر 200 mW (100*
	(mW
دارد (استفاده از class B و قابلیت تغییر گین با تغییر	قابلیت کاربردی اضافی
مقاومتهای فیدبک)	

توجه: فایل PCB به پیوست قرار دارد.